

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 217

Общие данные

Микросхемы серии 217 предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре.

Состав серии 217

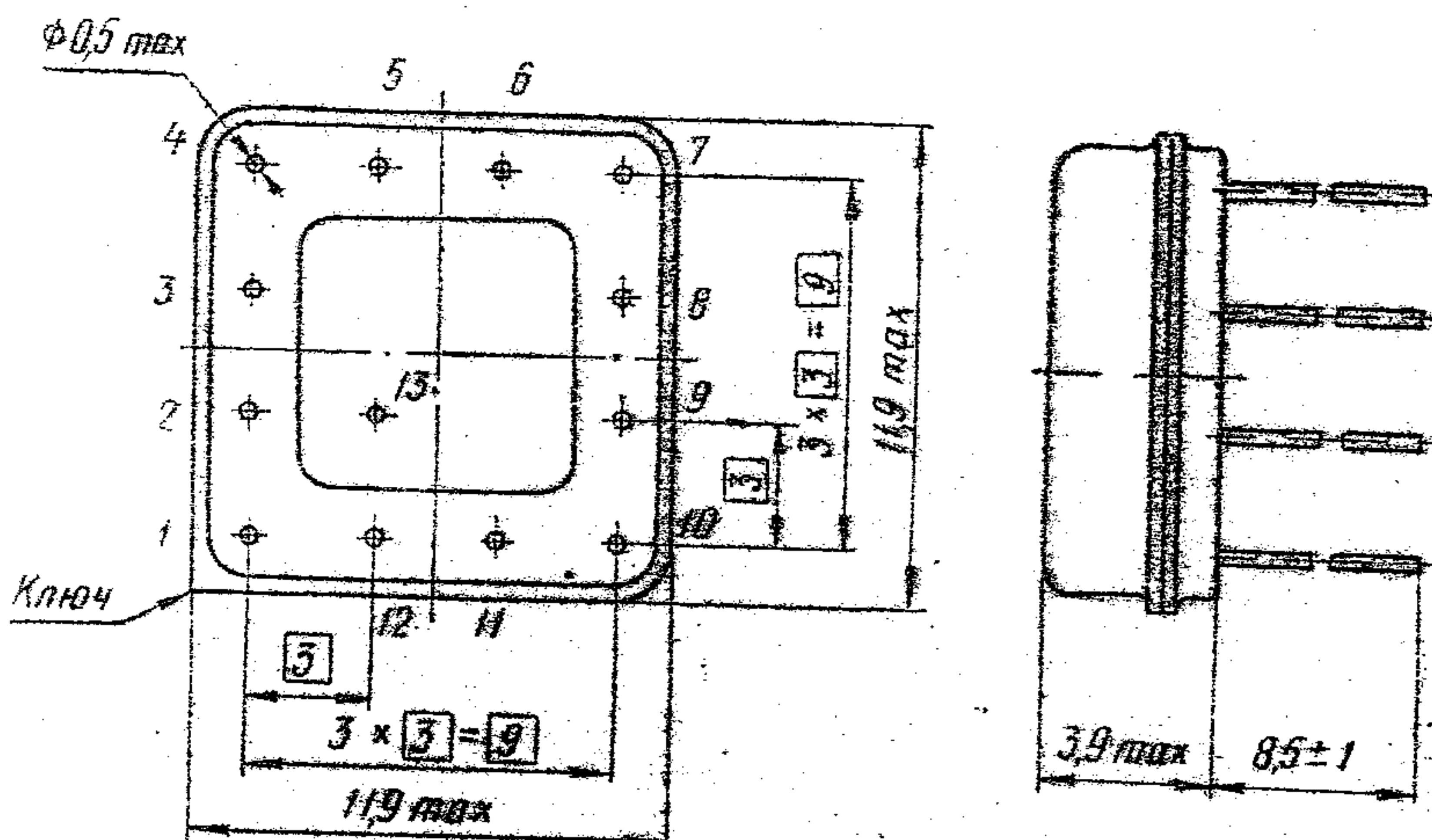
Сокращенное обозначение вида микросхемы	Функциональное назначение
217ДБ1 (А, Б)	Логический элемент «И—НЕ/ИЛИ—НЕ»
217ДБ2 (А, Б)	Логический элемент «И—ИИ—НЕ»
217ДБ3	Симистор расширитель
217ДБ4	Ресивер
217ДБ4 (А, Б)	Чипсет интегральный типа R-S-I
217ДР1	Чипсет типа R-S
217ДР2	Набор элементов интегральных
217ДР3 (А, Б)	Набор транзисторов
217ДР4	
217ДР5	
217ДР6	
217ДР7	
217ДР8	
217ДР9	

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 217

Общие данные

Микросхемы выполнены в прямоугольном металлоконституционном корпусе.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса — не более 2,5 г

Смещение осей выводов от номинального расположения не более 0,2 мм (допуск зависиткий).

Нумерация выводов микросхемы показана условно.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрация:

диапазон частот	от 1 до 5000 Гц
ускорение	40 g

Многократные удары:

ускорение	до 150 g
длительность удара	от 1 до 3 мс

Одиночные удары:

ускорение	до 1000 g
длительность удара	от 0,2 до 1 мс

Линейные нагрузки:

ускорение	до 500 g
---------------------	----------

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 217

Общие данные

Температура окружающей среды	от минус 60 до +70° С
Атмосферное давление	от 5 мм рт. ст. до 3 атм
Ниц., роса.	
Соленый туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Максимальная наработка	15 000 ч
Срок сохраняемости	15 лет

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В Г 073.01—75 и ГОСТ 0.340.001.

Монтаж микросхем в аппаратуре производить в соответствии с П. 5.4 ОСТ В Г 073.01—75 для микросхем с неформируемыми выводами.

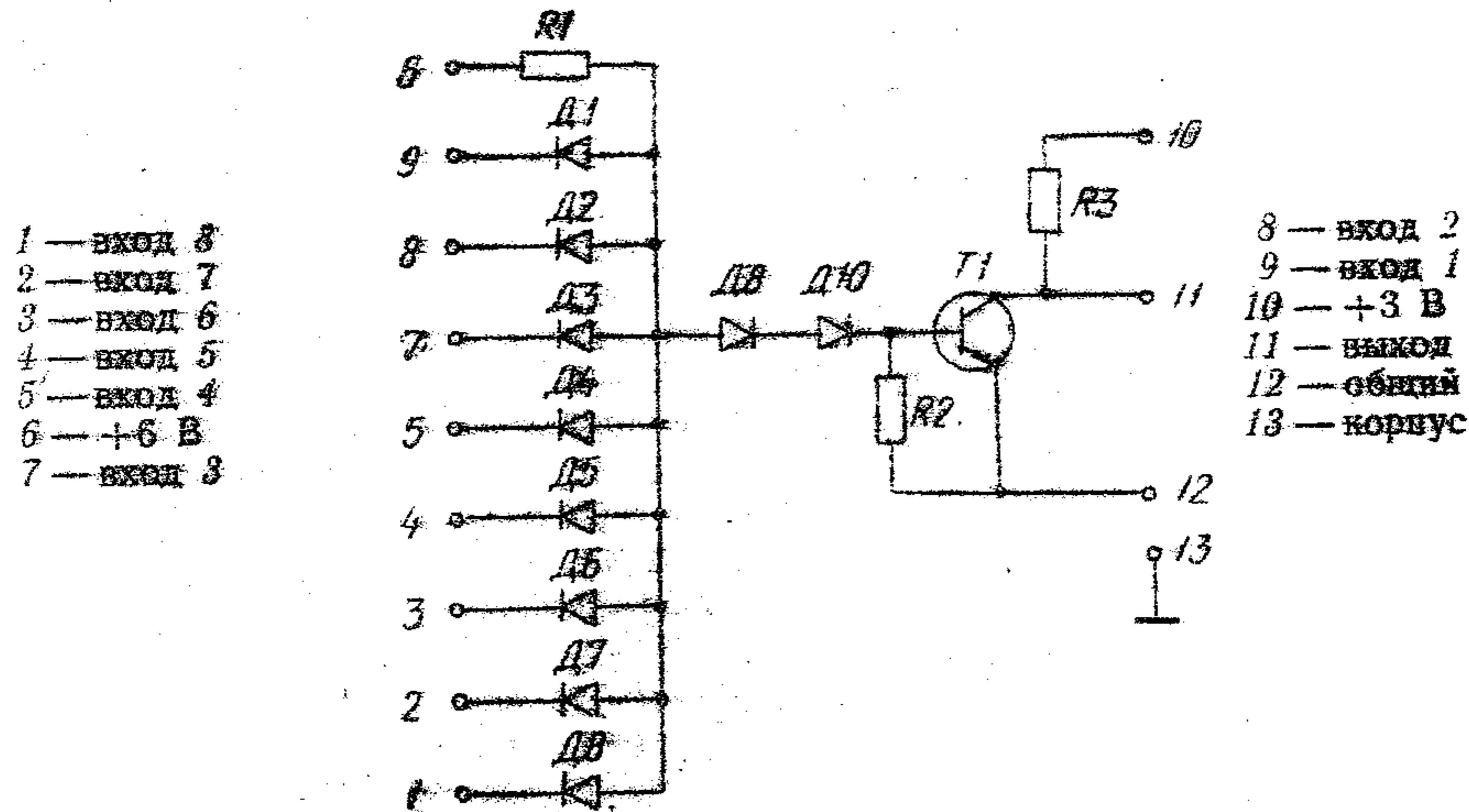
Использование за расстояние менее 1,5 мм от корпуса и на угол более 15° не допускается.

Допускается эксплуатация микросхем при напряжении источника питания $U_{\text{пит}} = +63 \text{ м} \pm 5\%$.

Длина линий от стекловой аппаратуры до микросхемы должна быть не более 90 см. Микросхемы после демонажа использовать запрещается.

Контактирование с металлической пайкой проводных элементов непосредственно с выводами кристаллов микросхемы. Допускаемое значение статического потенциала — 100 В.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$)

Напряжение источников питания:

$U_{\text{пит}}$	$+6 \text{ В} \pm 10\%$
$U_{\text{пит2}}$	$+3 \text{ В} \pm 10\%$

Потребляемая мощность:

от $U_{\text{пит}}$	не более 13 мВт
от $U_{\text{пит2}}$	не более 7,3 мВт

Выходной ток логического нуля

от 1,7 до 2,1 мА

Ток утечки на выходе

не более 1,0 мкА

Напряжение логической единицы при $U_{\text{пит}} = 0,9 \text{ В}$

не менее 2,6 В

Напряжение логического нуля при $U_{\text{пит}} = 2,0 \text{ В}$

не более 0,3 В

Время задержки распространения сигнала

при включении	не более 12 нс
при выключении	не более 35 нс

Нагрузочная способность микросхем:

217ЛБ1А	4 микросхемы
217ЛБ1А, (217ЛБ1Б)	6 микросхем
217ЛБ1А, (217ЛБ1Б)	217ЛБ1А, (217ЛБ1Б)

НАДЕЖНОСТЬ

Электрические параметры:

в течение минимальной изработки

напряжение логической единицы	не менее 2,5 В
напряжение логического нуля	не более 0,35 В
ток утечки на входе	не более 2,0 мА
время задержки распространения сигнала	

при включении

не более 15 нс

при выключении

не более 40 нс

в течение срока сохраняемости

ток утечки на входе

не более 2,0 мА

время задержки распространения сигнала

при включении

не более 15 нс

при выключении

не более 40 нс

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение источников питания:

$U_{ип1}$

+7,5 В

$U_{ип2}$

+4,0 В

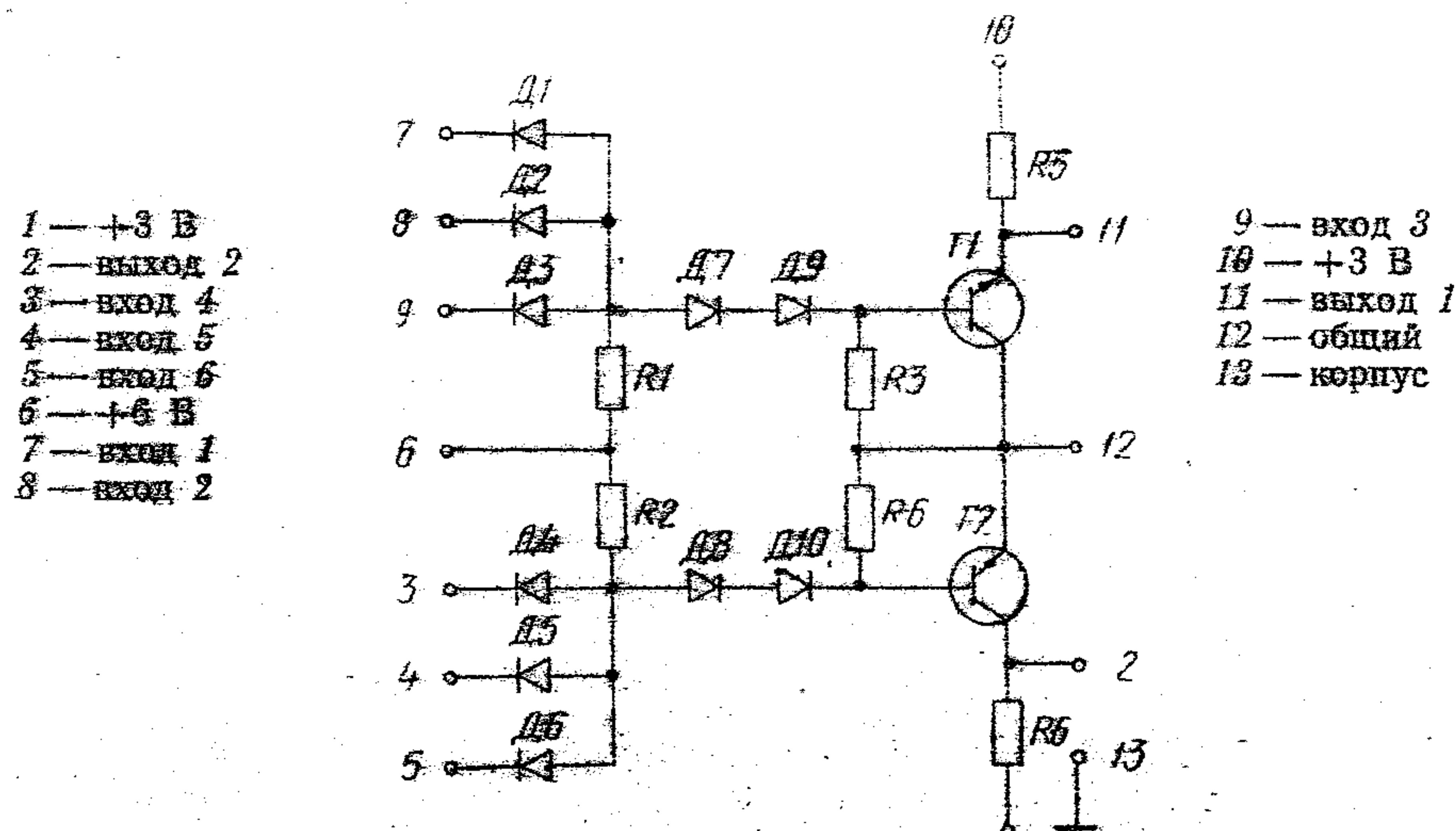
Входное напряжение

от минус 0,5 до +6 В

Ток нагрузки

10 мА

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$)

Напряжение источников питания:

 $U_{\text{пит}}$ +6 В ± 10% $U_{\text{пит2}}$ +3 В ± 10%

Потребляемая мощность:

от $U_{\text{пит}}$ не более 26 мВт
» $U_{\text{пит2}}$ не более 14,6 мВт

Выходной ток логического нуля

от 1,7 до 2,1 мА

Ток утечки на входе

не более 1 мкА

Напряжение логической единицы при $U_{\text{вх}} = 9$ В

не менее 2,6 В

Напряжение логического нуля при $U_{\text{вх}} = 2$ В

не более 0,3 В

Время задержки распространения сигнала:

при включении не более 12 нс

при выключении не более 30 нс

Нагрузочная способность микросхем:

217ЛБ2А 4 микросхемы 217ЛБ1

217ЛБ2Б 6 микросхем 217ЛБ1

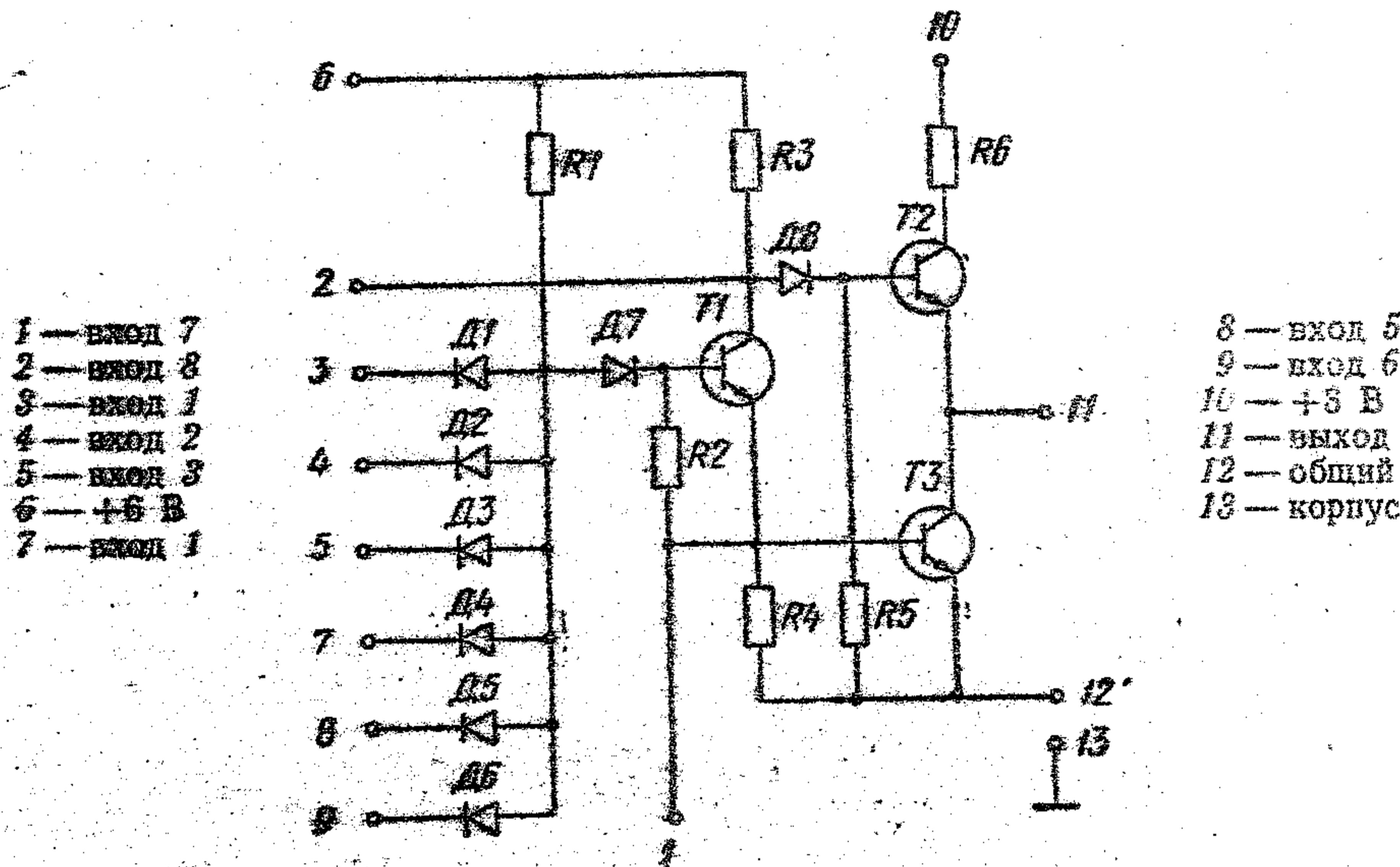
НАДЕЖНОСТЬ**Электрические параметры:**

в течение минимальной изработки	
напряжение логической единицы	не менее 2,5 В
напряжение логического нуля	не более 0,35 В
ток утечки на выходе	не более 2 мА
время задержки распространения сигнала	
при включении	не более 15 нс
при выключении	не более 40 нс
в течение срока сохраняемости	
ток утечки на выходе	не более 2,0 мА
время задержки распространения сигнала	
при включении	не более 15 нс
при выключении	не более 4 нс

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ****Напряжение источников питания:**

$U_{изл1}$	±7,5 В
$U_{изл2}$	±10 В
Входное напряжение	от минус 0,5 до 0,9 В
Ток нагрузки	не более 10 мА

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$)

Напряжение источников питания:

$U_{\text{пит1}}$	• • • • • • • • • • • • • • • •	+6 В ± 10%
$U_{\text{пит2}}$	• • • • • • • • • • • • • • • •	+3 В ± 10%

Потребляемая мощность:

$U_{\text{пит1}}$	• • • • • • • • • • • • • • • •	не более 32 мВт
$U_{\text{пит2}}$	• • • • • • • • • • • • • • • •	не более 7,3 мВт
Входной ток логического нуля	• • • • • • • • • • • • • • • •	от 1,0 до 1,5 мА
Напряжение логической единицы при $U_{\text{вх}} = 0,9$ В	• • • • • • • • • • • • • • • •	не менее 2,6 В
Напряжение логического нуля при $U_{\text{вх}} = 2,0$ В	• • • • • • • • • • • • • • • •	не более 0,3 В

Время задержки распространения сигнала:

при включении	• • • • • • • • • • • • • • • •	не более 2 нс
при выключении для микросхем	• • • • • • • • • • • • • • • •	
217ЛБ3	• • • • • • • • • • • • • • • •	не более 35 нс
217ЛБ3А	• • • • • • • • • • • • • • • •	не более 45 нс
Нагрузочная способность	• • • • • • • • • • • • • • • •	8 микросхем 217ЛБ1А, (217ЛБ1Б)

НАДЕЖНОСТЬ

Электрические параметры:

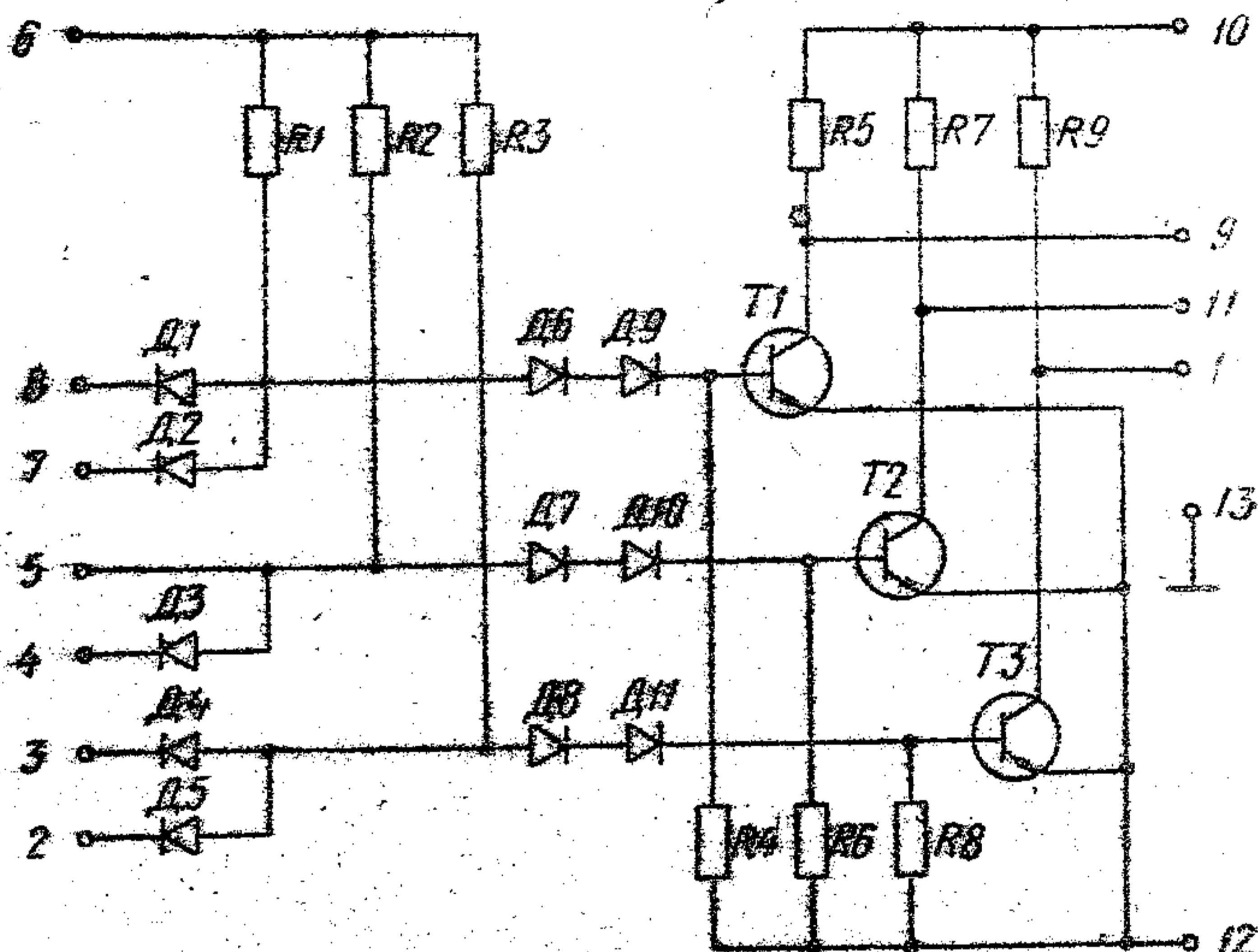
в течение минимальной изработки	
напряжение логической единицы	не менее 2,5 В
напряжение логического нуля	не более 0,35 В
ток утечки на входе	не более 2,0 мкА
время задержки распространения сигнала	
при включении	не более 25 нс
при выключении для микросхем	
217ЛБ3	не более 45 нс
217ЛБ3А	не более 60 нс
в течение срока сохраняемости	
время задержки распространения сигнала	
при включении	не более 25 нс
выключении для микросхем:	
217ЛБ3	не более 45 нс
217ЛБ3А	не более 60 нс

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение источников питания:

$U_{и.п1}$	+7,5 В
$U_{и.п2}$	+4,0 В
Входное напряжение	от минус 0,5 В до 6 В
Ток нагрузки	не более 20 мА

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



1 — вход 3
 2 — вход 6
 3 — вход 5
 4 — вход 4
 5 — выход 3
 6 — +6 В
 7 — выход 2

8 — вход 1
 9 — выход 1
 10 — +3 В
 11 — выход 2
 12 — общий
 13 — корпус

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$)

Напряжение источников питания:

$U_{\text{пит}1}$	$+6 \text{ В} \pm 10\%$
$U_{\text{пит}2}$	$+3 \text{ В} \pm 10\%$

Потребляемая мощность:

от $U_{\text{пит}1}$	не более 39 мВт
от $U_{\text{пит}2}$	не более 22 мВт
Входной ток логического нуля	от 1,7 до 2,1 мА
Ток утечки на выходе	не более 3,0 мкА
Напряжение логической единицы при $U_{\text{вх}} = 0,9 \text{ В}$	не менее 2,6 В
Напряжение логического нуля при $U_{\text{вх}} = 2,0 \text{ В}$	не более 0,3 В

217ЛБ4А
217ЛБ4Б

ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ «И—НЕ/ИЛИ—НЕ»

Время задержки распространения сигнала:

при включении не более 12 нс
при выключении не более 35 нс

Нагрузочная способность для микросхем:

217ЛБ4А 4 микросхемы 217ЛБ3
217ЛБ4Б 6 микросхем 217ЛБ3

НАДЕЖНОСТЬ

Электрические параметры:

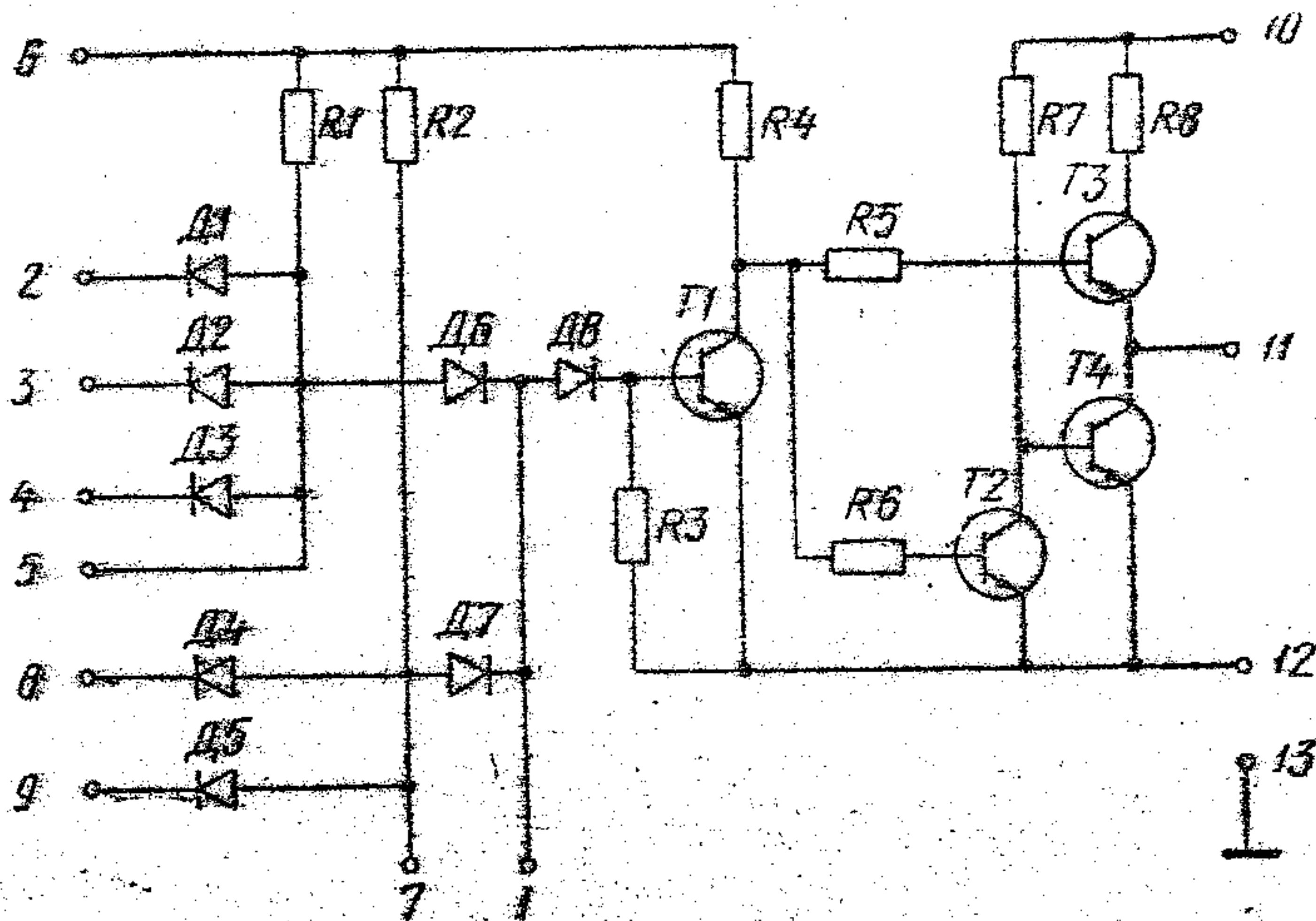
в течение минимальной наработки	
напряжение логической единицы	не менее 2,5 В
напряжение логического нуля	не более 0,35 В
ток утечки на входе	не более 2,0 мкА
время задержки распространения сигнала	
при включении	не более 15 нс
при выключении	не более 40 нс
в течение срока сохраняемости	
ток утечки на входе	не более 2,0 мкА
время задержки распространения сигнала	
при включении	не более 15 нс
при выключении	не более 40 нс

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Напряжение питания:

$U_{ил1}$	+2,5 В
$U_{ил2}$	+4,0 В
Входное напряжение	от минус 0,5 до 6,0 В
Ток нагрузки	не более 20 мА

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



1 — вход 1
 2 — вход 3
 3 — вход 2
 4 — вход 3
 5 — вход 4
 6 — +6 В
 7 — вход 7

8 — вход 5
 9 — вход 6
 10 — +3 В
 11 — выход
 12 — общий
 13 — корпус

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$)

Напряжение источников питания:

$U_{\text{ил1}}$	$+6 \text{ В} \pm 10\%$
$U_{\text{ил2}}$	$+3 \text{ В} \pm 10\%$

Потребляемая мощность:

от $U_{\text{ил1}}$	не более 29 мВт
от $U_{\text{ил2}}$	не более 7,3 мВт

Входной ток логического «0»

Ток утечки на входе при $U_{\text{вх}} = 5,0 \text{ В}$ Напряжение логического «0» при $U_{\text{вх}} = 2,0 \pm 1\%$ Напряжение логической «1» при $U_{\text{вх}} = 0,9 \text{ В} \pm 2\%$

от 1,25 до 1,6 мА
не более 1,0 мкА

не более 0,3 В

не менее 2,6 В

Время задержки распространения сигнала:

при включении от 40 до 100 мс
при выключении от 30 до 100 мс

Нагрузочная способность 8 микросхем 217ЛБ1А
или 217ЛБ1Б

НАДЕЖНОСТЬ

Электрические параметры:

в течение минимальной наработки	
напряжение логического «0» при $U_{\text{вх}} = 2,2 \text{ В}$	не более 0,35 В
напряжение логической «1» при $U_{\text{вх}} = 0,8 \text{ В}$	не менее 2,5 В
ток утечки на выходе* при $U_{\text{вх}} = 5 \text{ В}$	не более 2,0 мА
время задержки распространения сигнала*	
при включении	от 40 до 120 мс
при выключении	от 25 до 100 мс

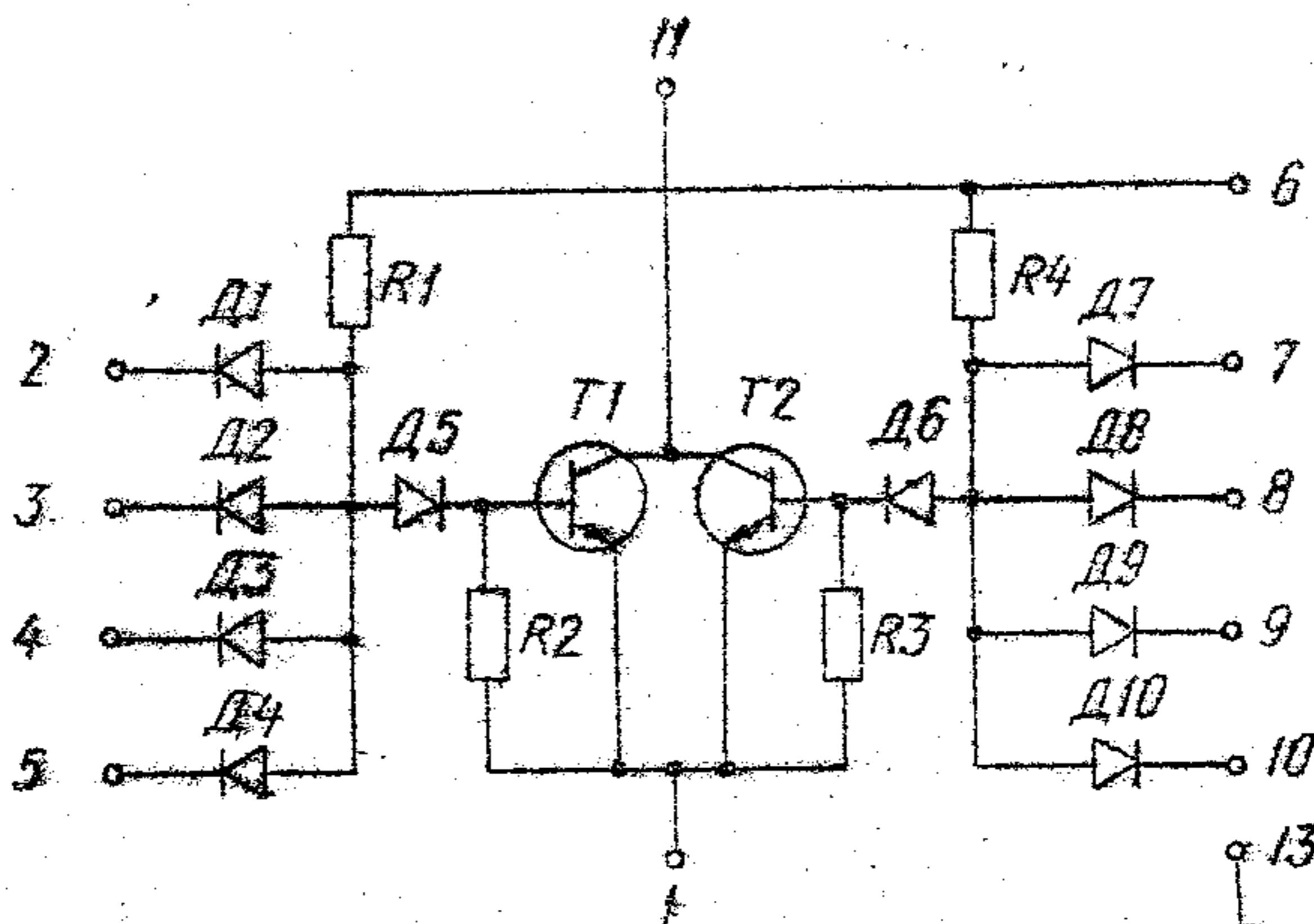
ПРЕДЕЛЬНО ДОЗУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное напряжение источников питания:

$U_{\text{ил1}}$	+7,5 В
$U_{\text{ил2}}$	+4,0 В
Максимальное входное напряжение	60 В
Минимальное входное напряжение	минус 0,5 В
Максимальный ток нагрузки	20 мА

* Параметр надежности в течение срока сохраняемости.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



1 — выход 2
 2 — вход 1
 3 — вход 2
 4 — вход 3
 5 — вход 4
 6 — +6 В
 7 — вход 5

8 — вход 6
 9 — вход 7
 10 — вход 8
 11 — выход 1
 12 — свободный
 13 — корпус

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$)

Напряжение источника питания	$+6 \text{ В} \pm 10\%$
Потребляемая мощность	не более 18,5 мВт
Входной ток логического «0»	от 1,0 до 1,5 мА
Ток утечки на входе при $U_{\text{вх}} = 5,0 \text{ В}$	не более 1 мкА
Ток утечки на выходе	не более 2 мкА
Напряжение логического «0» при $U_{\text{вх}} = 1,4 \text{ В}$	не более 0,3 В
Напряжение логической «1» при $U_{\text{вх}} = 0,3 \text{ В}$	не менее 5,3 В
Время задержки распространения сигнала:	
при включении	не более 12 нс
при выключении	не более 40 нс

НАДЕЖНОСТЬ

Электрические параметры в течение минимальной наработки:

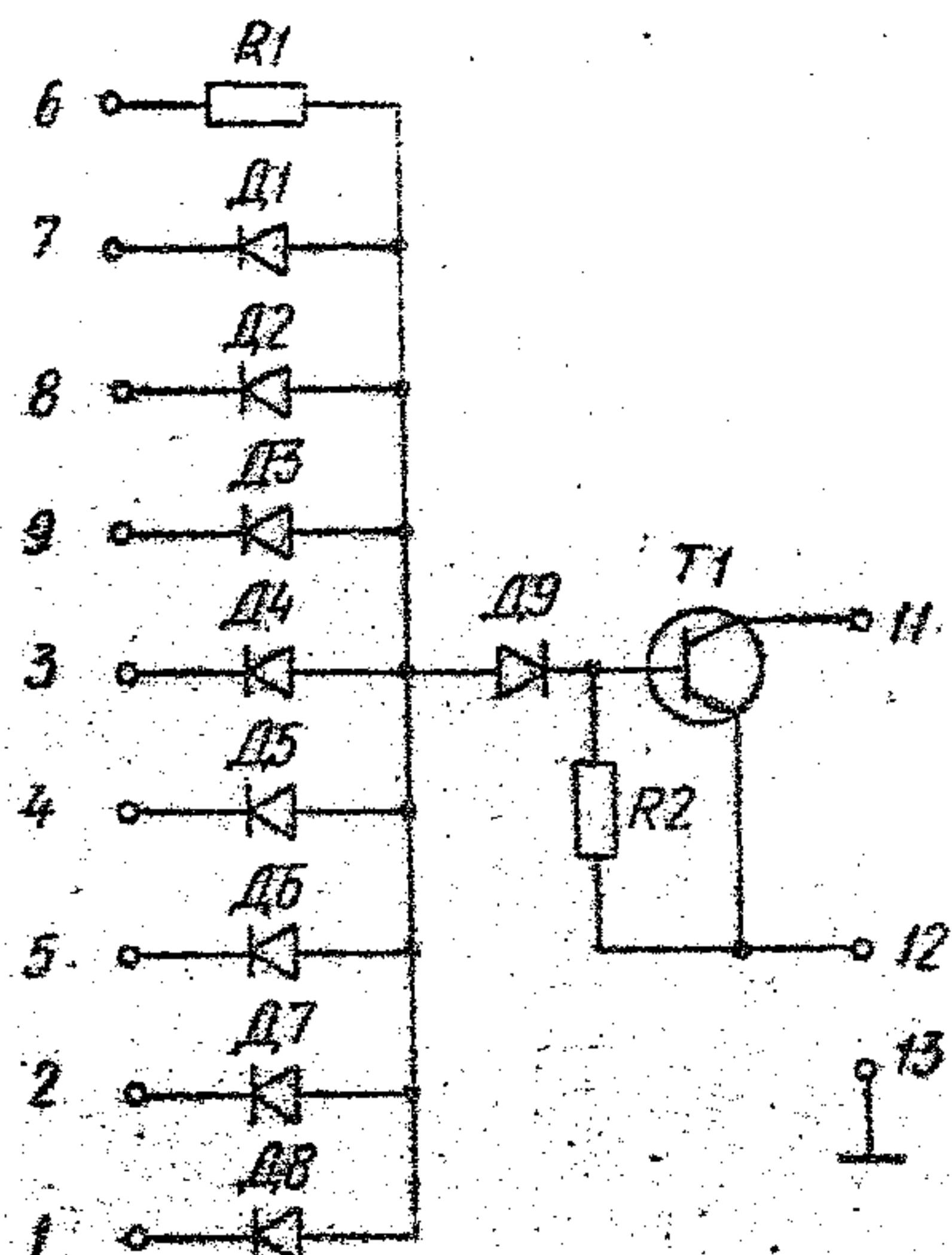
напряжение логического «0» при $U_{вх} = 1,6$ В	не более 0,35 В
напряжение логической «1» при $U_{вх} = 0,3$ В	не менее 5,2 В
ток утечки на входе* при $U_{вх} = 5,0$ В	не более 2,0 мкА
время задержки распространения сигнала *	
при включении	не более 15 нс
при выключении	не более 45 нс

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
В РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное напряжение питания	+75 В
Максимальное входное напряжение	6 В
Минимальное входное напряжение	минус 0,5 В
Максимальный ток нагрузки	20 мА

* Параметр надежности в течение срока сохраняемости.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



- | | |
|------------|----------------|
| 1 — вход 8 | 8 — вход 2 |
| 2 — вход 7 | 9 — вход 3 |
| 3 — вход 4 | 10 — свободный |
| 4 — вход 5 | 11 — выход 1 |
| 5 — вход 6 | 12 — выход 2 |
| 6 — +6 В | 13 — корпус |
| 7 — вход 1 | |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 5^\circ \text{C}$)

Напряжение источника питания	$+6 \text{ В} \pm 10\%$
Потребляемая мощность	не более 9 мВт
Выходной ток логического «0»	от 1,0 до 1,5 мА
Ток утечки на входе при $U_{\text{вх}} = 5,0 \text{ В}$	не более 1 мкА
Ток утечки на выходе	не более 1 мкА
Напряжение логического «0» при $U_{\text{вх}} = 1,4 \text{ В}$	не более 0,3 В
Напряжение логической «1» при $U_{\text{вх}} = 0,3 \text{ В}$	не менее 5,3 В
Время задержки распространения сигнала при включении	не более 12 нс
при выключении	не более 35 нс

НАДЕЖНОСТЬ

Электрические параметры в течение минимальной наработки:

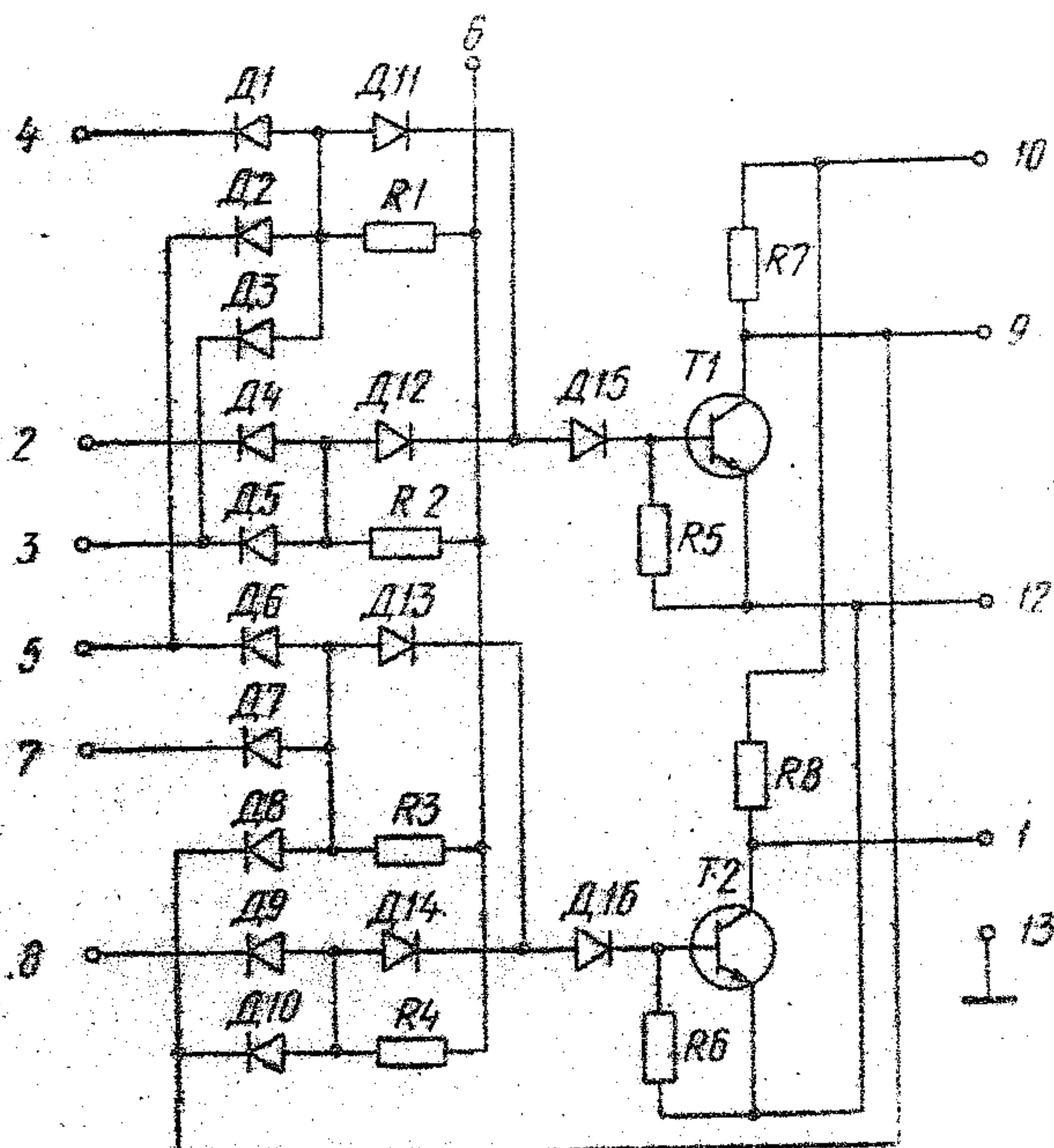
напряжение логического «0» при $U_{вх}=1,6$ В	не более 0,35 В
напряжение логической «1» при $U_{вх}=0,3$ В	не менее 5,2 В
ток утечки на входе* при $U_{вх}=5,0$ В	не более 2,0 мкА
время задержки распространения сигнала*	
при включении	не более 15 нс
при выключении	не более 40 нс

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное напряжение питания	+7,5 В
Максимальное входное напряжение	6,0 В
Минимальное входное напряжение	минус 0,5 В
Максимальный ток нагрузки	20 мА

* Параметр надежности в течение срока сохраняемости.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



- 1 — выход «0»
- 2 — установка «1»
- 3 — обратная связь
- 4 — управление «1»
- 5 — счет
- 6 — +6 В
- 7 — управление «0»

- 8 — установка «0»
- 9 — выход «1»
- 10 — +3 В
- 11 — свободный
- 12 — общий
- 13 — корпус

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$)

Напряжение источников питания:

$U_{\text{в.м.}}$	$+6 \text{ В} \pm 10\%$
$U_{\text{в.д.2}}$	$+3 \text{ В} \pm 10\%$

Потребляемая мощность:

от $U_{\text{в.м.1}}$	не более 52 мВт
от $U_{\text{в.д.2}}$	не более 7,3 мВт

217TK1A
217TK1B

ТРИГГЕР КОМБИНИРОВАННЫЙ ТИПА R-S-T

Входной ток логического «0» на входах:

4, 7

2, 8

от 2,8 до 3,5 мА

от 1,4 до 1,8 мА

не более 1 мкА

не более 2 мкА

не более 0,3 В

не менее 2,6 В

Ток утечки на входе

Ток утечки на выходе

Напряжение логического «0» при $U_{bx} = 2,0$ В

Напряжение логической «1» при $U_{bx} = 0,9$ В

Выходная частота* при $U_{bx} = 3,0$ В; $\tau_{phi,bx} \leq 20$ нс
для микросхем:

217TK1A

1,5 МГц

217TK1B

2,5 МГц

Частота установки при $U_{bx} = 3,0$ В; $\tau_{phi,bx} \leq 20$ нс,
 $f_{bx} = 3$ МГц

3 МГц

Нагрузочная способность

4 микросхемы 217ЛВ1А
(217ЛБ1Б) или 2 мик-
росхемы 217ЛВ1А
(217ЛБ1Б) и 1 мик-
росхема 217TK1A
(217TK1B) по счетному
входу

НАДЕЖНОСТЬ

Электрические параметры в течение минимальной
наработки:

напряжение логического «0»

не более 0,35 В

напряжение логической «1»

не менее 2,5 В

ток утечки на входе*

не более 2,0 мкА

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное напряжение источников питания:

$U_{и.п1}$

+7,5 В

$U_{и.п2}$

+4,0 В

Максимальное входное напряжение

6 В

Минимальное входное напряжение

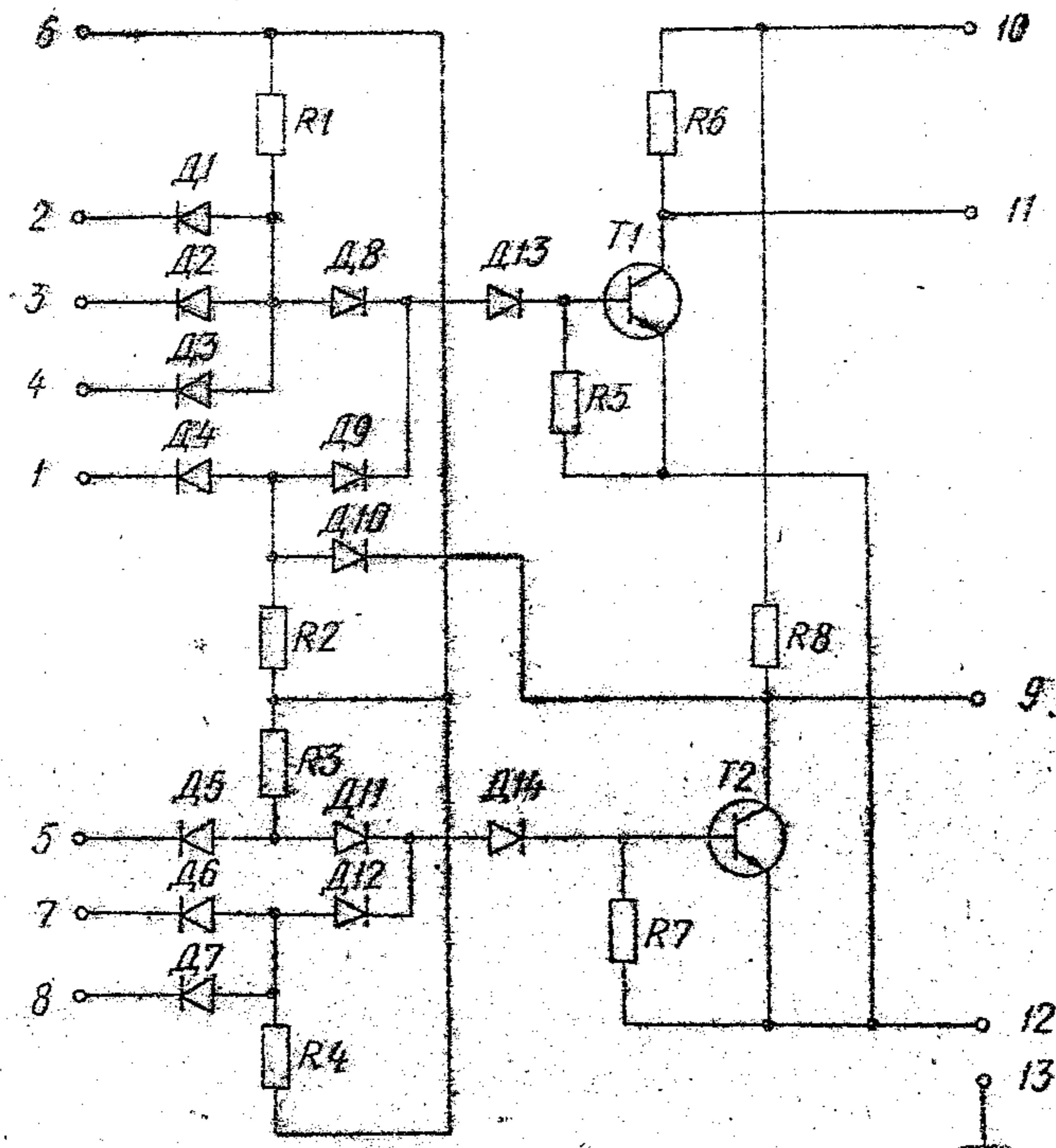
минус 0,5 В

Максимальный ток нагрузки

10 мА

* Параметр надежности в течение срока сохраняемости.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



1 — сброс
 2, 4 — установки «1»
 5 — обратная связь
 6 — +6 В
 7, 8 — установки «0»
 9 — выход «0»
 10 — +3 В
 11 — выход «1»
 12 — общий
 13 — корпус

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 5^\circ \text{C}$)

Напряжение источников питания:

$U_{\text{в.п1}}$	$+6 \text{ В} \pm 10\%$
$U_{\text{в.п2}}$	$+3 \text{ В} \pm 10\%$

Потребляемая мощность:

от $U_{\text{и.п1}}$	не более 31 мВт
от $U_{\text{и.п2}}$	не более 7,3 мВт
Входной ток логического «0»	от 1,7 до 2,1 мА
Ток утечки на входе	не более 1 мкА
Ток утечки на выходе	не более 2 мкА
Напряжение логического «0» при $U_{\text{вх}} = 2,0$ В	не более 0,3 В
Напряжение логической «1» при $U_{\text{вх}} = 0,9$ В	не менее 2,6 В
Частота установки при $U_{\text{вх}} = 3,0$ В; $\tau_{\text{вх}} = 83$ нс; $\tau_{\text{ф.вх}} \leq 20$ нс; $f_{\text{вх}} = 3$ МГц	3 МГц

Нагрузочная способность для микросхем:

217ТР1А	4 микросхемы 217ЛБ1А или 217ЛБ1Б
217ТР1Б	6 микросхем 217ЛБ1А или 217ЛБ1Б

НАДЕЖНОСТЬ

Электрические параметры в течение минимальной наработки:

ток утечки на входе* при $U_{\text{вх}} = 5,0$ В	не более 2 мкА
напряжение логического «0» при $U_{\text{вх}} = 0,8$ В	не более 0,35 В
напряжение логической «1» при $U_{\text{вх}} = 2,2$ В	не менее 2,5 В
частота установки*	2,5 МГц

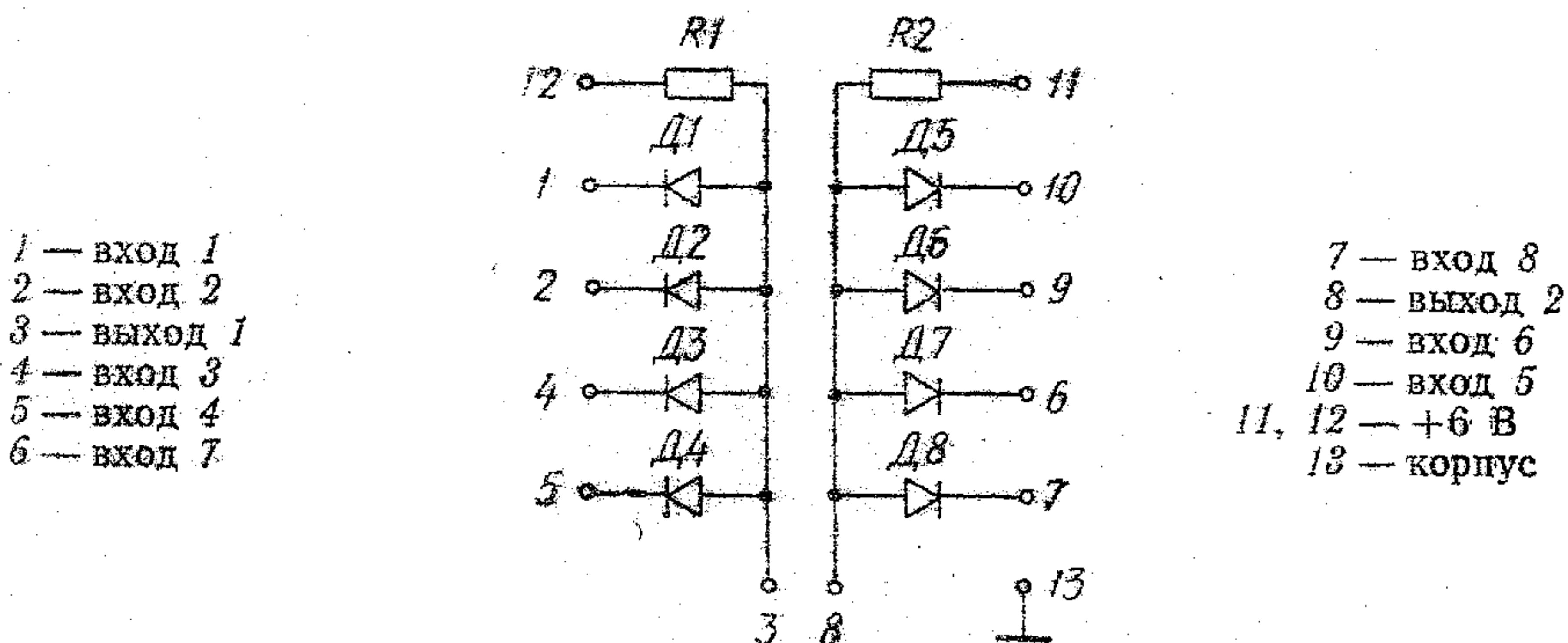
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное напряжение источников питания:

$U_{\text{и.п1}}$	+7,5 В
$U_{\text{и.п2}}$	+4,0 В
Максимальное входное напряжение	6,0 В
Минимальное входное напряжение	минус 0,6 В
Максимальный ток нагрузки	15 мА

* Параметр надежности в течение срока сохраняемости.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$)

Напряжение источника питания	$+6 \text{ В} \pm 10\%$
Потребляемая мощность	не более 11 мВт
Входной ток логического «0»	от 1,0 до 1,5 мА
Ток утечки на входе	не более 1,0 мкА
Прямое падение напряжения:	
при $I_{\text{пр}} = 0,05 \text{ мА}$	не менее 0,5 В
при $I_{\text{пр}} = 1,0 \text{ мА}$	не более 0,8 В

НАДЕЖНОСТЬ

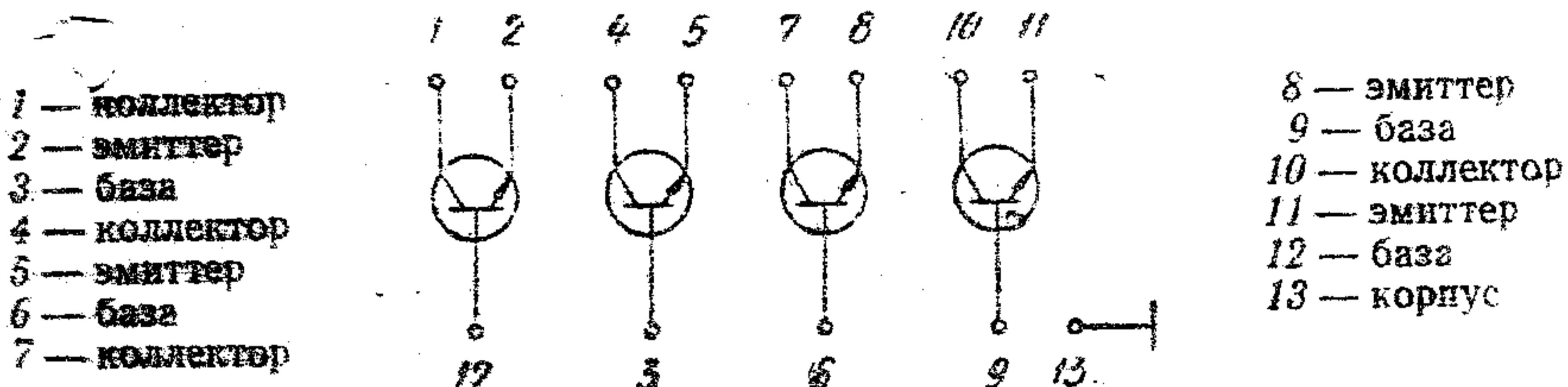
Электрические параметры в течение минимальной наработки:

ток утечки на входе	не более 5,0 мкА
прямое падение напряжения	не более 0,85 В

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное обратное напряжение на диоде	6 В
Максимальный прямой ток через диод	5 В
Максимальный ток через резисторы	2 мА

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$)Обратный ток коллектора при $U_K = 7\text{ В}$

не более 1 мА

Напряжение коллектор—эмиттер в режиме насыщенностя *

не более 0,33 В

Напряжение база—эмиттер в режиме насыщения при $U_K = 10\text{ мА}$; $I_B = 1\text{ мА}$

не более 1 В

Напряжение сатuration при $U_K = 10\text{ мА}$

не менее 0,55 В

Статический коэффициент передачи тока при $I_B = -10\text{ мА}$ для микросхем:

217НТ1

30—90

217НТ2

70—150

217НТ3

70—280

Время рассасывания при $I_K = 10\text{ мА}$; $I_{B1} = 2\text{ мА}$; $I_{B2} = 1\text{ мА}$

не более 25 нс

НАДЕЖНОСТЬ

Электрические параметры в течение минимальной наработки:

обратный ток коллектора при $U_K = 7\text{ В}$

не более 5 мА

напряжение коллектор—эмиттер в режиме насыщенностя *

не более 0,37 В

* При $I_B = 10\text{ мА}$. $I_B = 1\text{ мА}$ — для 217НТ1; $I_B = 0,6\text{ мА}$ — для 217НТ2; $I_B = 0,43\text{ мА}$ — для 217НТ3.

217НТ1
217НТ2
217НТ3

НАБОР ТРАНЗИСТОРОВ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальная рассеиваемая мощность микросхемы
при работе:

одного транзистора	20 мВт
двух транзисторов	40 мВт
трех транзисторов	60 мВт
четырех транзисторов	80 мВт
Максимальное напряжение коллектор—база	10 В
Максимальное напряжение коллектор—эмиттер	10 В
Максимальное напряжение эмиттер—база	3,5 В
Максимальный ток коллектора	20 мА
Импульсный ток коллектора при $t_{имп} \leq 10 \text{ мкс}$, $\tau_\phi \leq 100 \text{ нс}, \frac{T}{\tau} = 10$	45 мА

Размножено
35 шт.
по叫我

Справка
разрешено: Код:
по т. распечатки
справочника